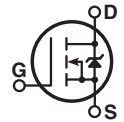
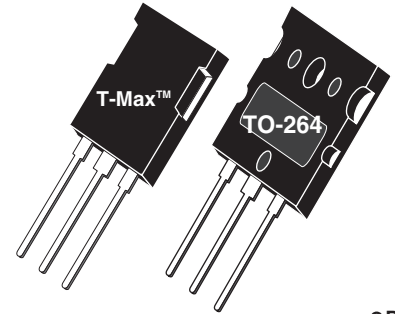


LINEAR MOSFET

Linear Mosfets are optimized for applications operating in the Linear region where concurrent high voltage and high current can occur at near DC conditions (>100 msec).



- Higher FBSOA
- Higher Power Dissipation
- Popular T-MAX™ or TO-264 Package


MAXIMUM RATINGS

All Ratings: $T_C = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified.

| Symbol | Parameter | APL502B2_L (G) | UNIT |
|----------------|--|----------------|-------|
| V_{DSS} | Drain-Source Voltage | 500 | Volts |
| I_D | Continuous Drain Current @ $T_C = 25^\circ\text{C}$ | 58 | Amps |
| I_{DM} | Pulsed Drain Current ^① | 232 | |
| V_{GS} | Gate-Source Voltage Continuous | ±30 | Volts |
| V_{GSM} | Gate-Source Voltage Transient | ±40 | |
| P_D | Total Power Dissipation @ $T_C = 25^\circ\text{C}$ | 730 | Watts |
| | Linear Derating Factor | 5.84 | W/°C |
| T_J, T_{STG} | Operating and Storage Junction Temperature Range | -55 to 150 | °C |
| T_L | Lead Temperature: 0.063" from Case for 10 Sec. | 300 | |
| I_{AR} | Avalanche Current ^① (Repetitive and Non-Repetitive) | 58 | Amps |
| E_{AR} | Repetitive Avalanche Energy ^① | 50 | mJ |
| E_{AS} | Single Pulse Avalanche Energy ^④ | 3000 | |

STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

| Symbol | Characteristic / Test Conditions / Part Number | MIN | TYP | MAX | UNIT |
|---------------------|--|-----|-----|------|---------------|
| BV_{DSS} | Drain-Source Breakdown Voltage ($V_{GS} = 0V, I_D = 250 \mu\text{A}$) | 500 | | | Volts |
| $I_D(\text{ON})$ | On State Drain Current ^② ($V_{DS} > I_D(\text{ON}) \times R_{DS}(\text{ON}) \text{ Max}, V_{GS} = 12V$) | 58 | | | Amps |
| $R_{DS}(\text{ON})$ | Drain-Source On-State Resistance ^② ($V_{GS} = 12V, 29A$) | | | 0.09 | Ohms |
| I_{DSS} | Zero Gate Voltage Drain Current ($V_{DS} = 500V, V_{GS} = 0V$) | | | 25 | μA |
| | Zero Gate Voltage Drain Current ($V_{DS} = 400V, V_{GS} = 0V, T_C = 125^\circ\text{C}$) | | | 250 | |
| I_{GSS} | Gate-Source Leakage Current ($V_{GS} = \pm 30V, V_{DS} = 0V$) | | | ±100 | nA |
| $V_{GS}(\text{TH})$ | Gate Threshold Voltage ($V_{DS} = V_{GS}, I_D = 2.5\text{mA}$) | 2 | | 4 | Volts |

 **CAUTION:** These Devices are Sensitive to Electrostatic Discharge. Proper Handling Procedures Should Be Followed.

DYNAMIC CHARACTERISTICS

APL502B2_L(G)

| Symbol | Characteristic | Test Conditions | MIN | TYP | MAX | UNIT |
|--------------|------------------------------|---|-----|------|------|------|
| C_{iss} | Input Capacitance | $V_{GS} = 0V$ $V_{DS} = 25V$ $f = 1\text{ MHz}$ | | 7485 | 9000 | pF |
| C_{oss} | Output Capacitance | | | 1290 | 1810 | |
| C_{rss} | Reverse Transfer Capacitance | | | 617 | 930 | |
| $t_{d(on)}$ | Turn-on Delay Time | $V_{GS} = 15V$ $V_{DD} = 250V$ $I_D = 29A @ 25^\circ C$ $R_G = 0.6W$ | | 13 | 26 | ns |
| t_r | Rise Time | | | 27 | 54 | |
| $t_{d(off)}$ | Turn-off Delay Time | | | 56 | 84 | |
| t_f | Fall Time | | | 16 | 20 | |

THERMAL CHARACTERISTICS

| Symbol | Characteristic | MIN | TYP | MAX | UNIT |
|-----------|------------------|-----|------|-----|--------------|
| R_{qJC} | Junction to Case | | | .17 | $^\circ C/W$ |
| W_T | Package Weight | | 0.22 | | oz |
| | | | 5.9 | | g |

- ① Repetitive Rating: Pulse width limited by maximum junction temperature.
- ② Pulse Test: Pulse width < 380 μs , Duty Cycle < 2%
- ③ See MIL-STD-750 Method 3471
- ④ Starting $T_j = +25^\circ C$, $L = 1.78mH$, $R_G = 25W$, Peak $I_L = 58A$
- Microsemi reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein.

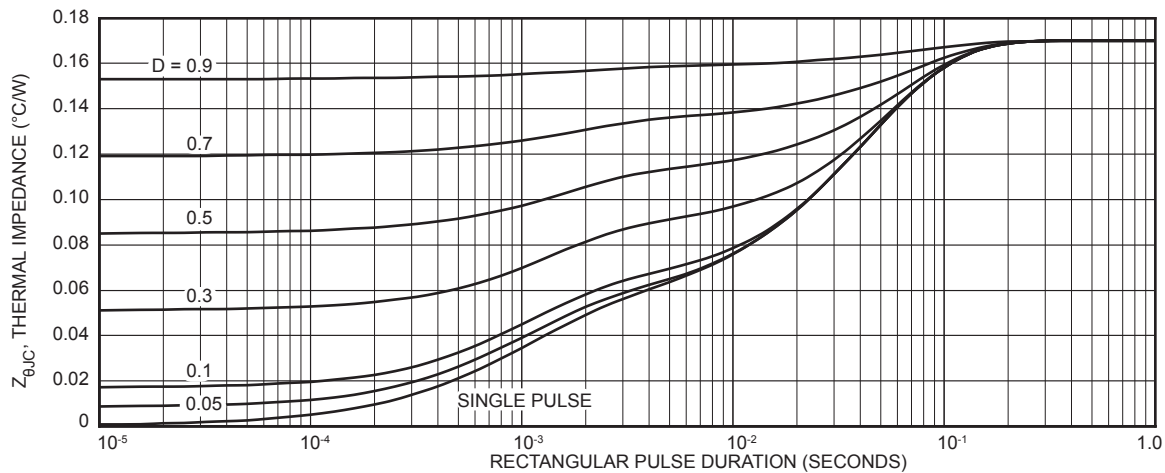


FIGURE 1, MAXIMUM EFFECTIVE TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE, JUNCTION-TO-CASE vs PULSE DURATION

Typical Performance Curves

APL502B2_L(G)

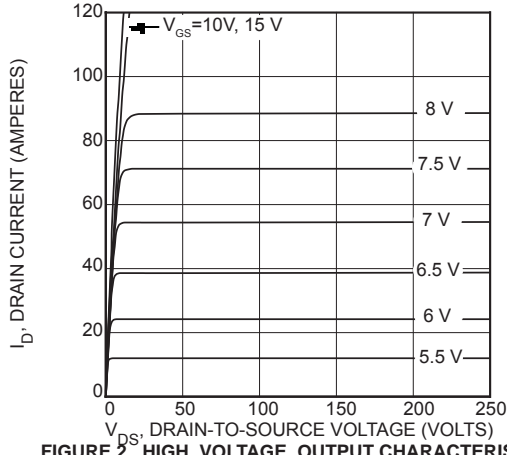


FIGURE 2, HIGH VOLTAGE OUTPUT CHARACTERISTICS

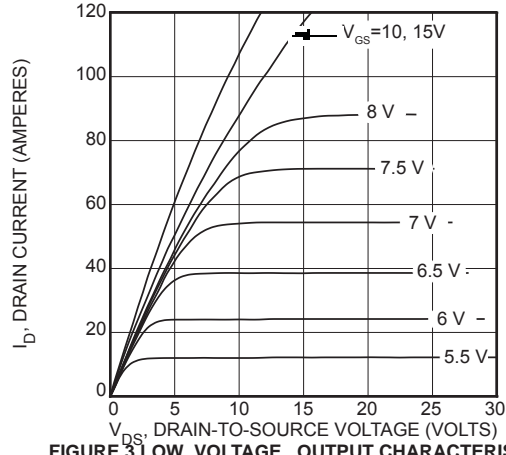


FIGURE 3, LOW VOLTAGE OUTPUT CHARACTERISTICS

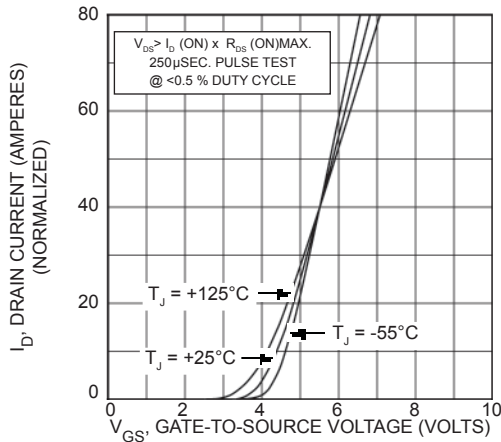


FIGURE 4, TRANSFER CHARACTERISTICS

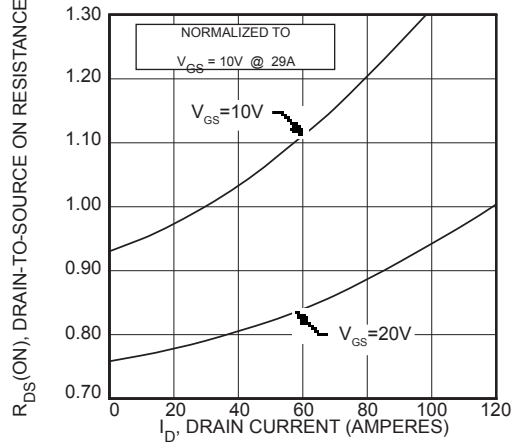


FIGURE 5, $R_{DS(ON)}$ vs DRAIN CURRENT

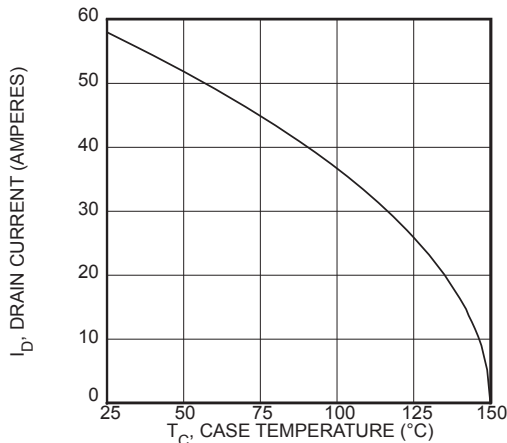


FIGURE 6, MAXIMUM DRAIN CURRENT vs CASE TEMPERATURE

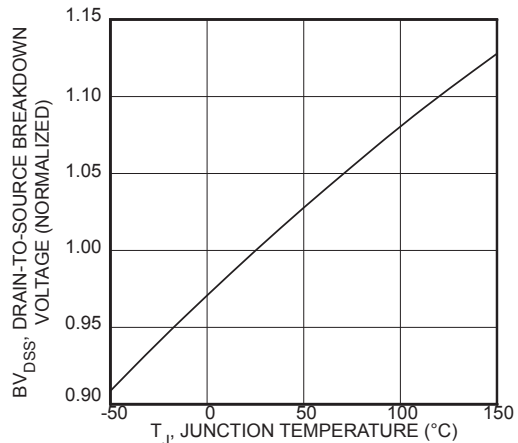


FIGURE 7, BREAKDOWN VOLTAGE vs TEMPERATURE

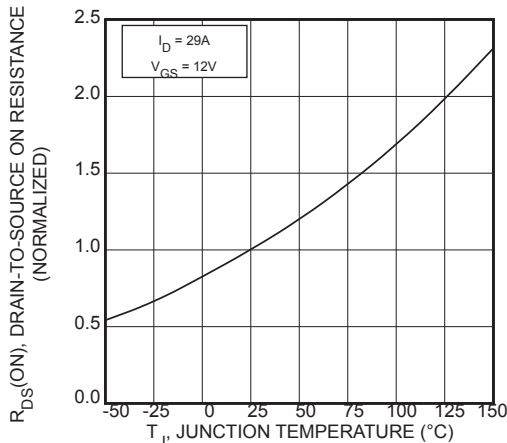


FIGURE 8, ON-RESISTANCE vs. TEMPERATURE

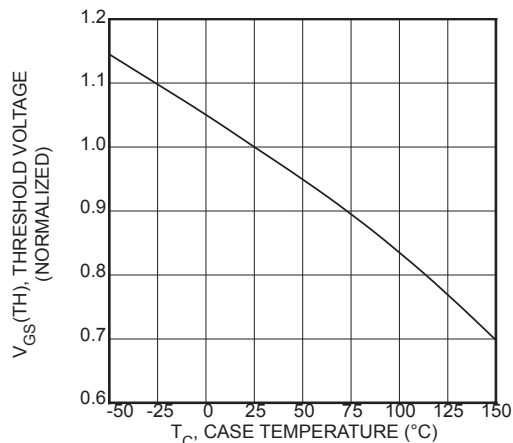


FIGURE 9, THRESHOLD VOLTAGE vs TEMPERATURE

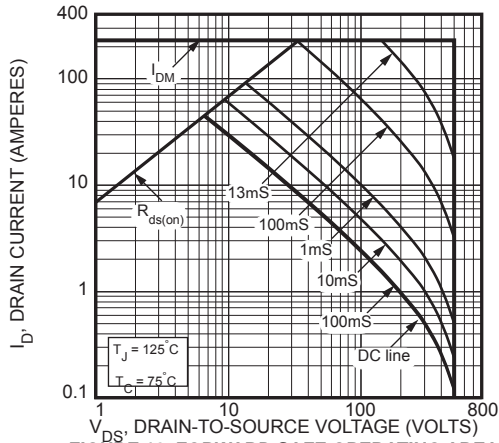


FIGURE 10, FORWARD SAFE OPERATING AREA

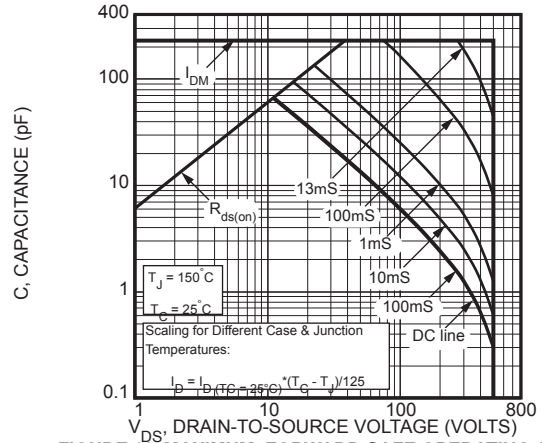


FIGURE 11, MAXIMUM FORWARD SAFE OPERATING AREA

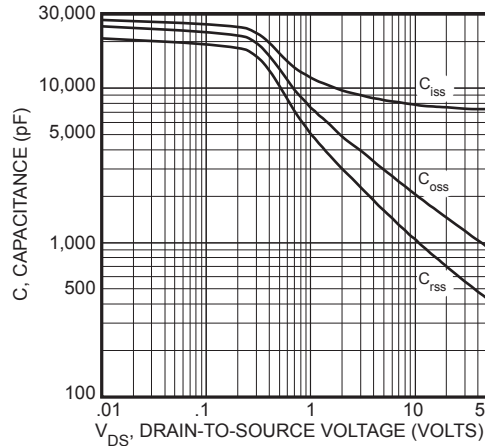
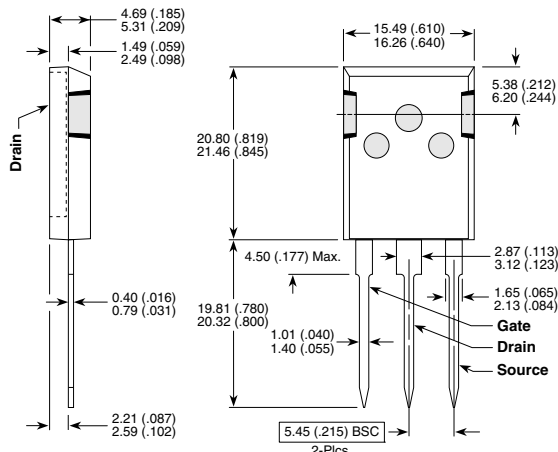


FIGURE 12, CAPACITANCE vs DRAIN-TO-SOURCE VOLTAGE

T-MAX™ (B2) Package Outline

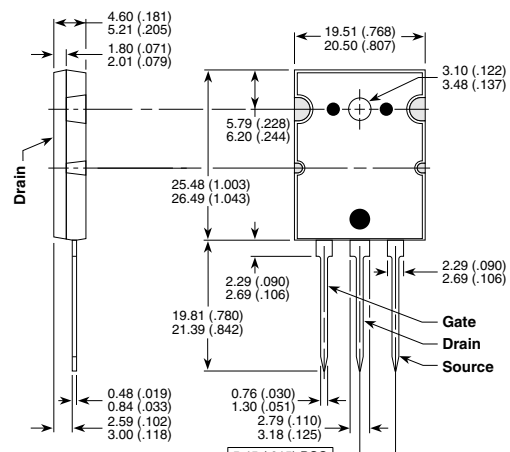
TO-264 (L) Package Outline

e1 SAC 96.5% Sn, 3.0% Ag, 0.5% Cu Plated



These dimensions are equal to the TO-247 without the mounting hole.

Dimensions in Millimeters and (Inches)



Dimensions in Millimeters and (Inches)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А